

ダイオードブリッジ部(6素子) Part of Diode Bridge(6 Arm.)

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value	単位 Unit
ピーク逆電流 Peak Reverse Current	*1 I _{RM}	T _j = 125°C, V _{RM} = V _{RRM}	20	mA
ピーク順電圧 Peak Forward Voltage	*1 V _{FM}	T _j = 25°C, I _{FM} = 200A	1.32	V
熱抵抗 Thermal Resistance	R _{th(j-c)}	接合部-ケース間(トータル) Junction to Case, Total	0.07	°CW

*1 : 1アーム当たりの値 Value Per 1 Arm.

サイリスタ部(1素子) Part of Thyristor(1 Arm.)

■最大定格 Maximum Rating

項目 Parameter	記号 Symbol	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
くり返しピークオフ電圧 Repetitive Peak Off State Voltage	*2 V _{DRM}	800	V
非くり返しピークオフ電圧 Non-Repetitive Peak Off State Voltage	*2 V _{DSM}	900	V

*2 : 逆電圧を印加しないこと Can not be Biased for Thyristor

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	定格値 Max. Rated Value	単位 Unit
サージオン電流 Surge On-State Current	I _{1SM}	50Hz 正弦半波, 1サイクル, 非くり返し Half Sine Wave, 1Pulse, Non-Repetitive	4000	A
電流二乗時間積 I Squared t	I ² t	2~10ms	80000	A ² s
臨界オン電流上昇率 Critical Rate of Rise of Turned-On Current	di/dt	V _D = 2/3 V _{DRM} , I _{TM} = 2 · I _o , T _j = 125°C I _G = 300mA, di _G /dt = 0.2A/μs	100	A/μs
ピークゲート電力損失 Peak Gate Power	P _{GM}		5	W
平均ゲート電力損失 Average Gate Power	P _{G(AV)}		1	W
ピークゲート電流 Peak Gate Current	I _{GM}		2	A
ピークゲート電圧 Peak Gate Voltage	V _{GM}		10	V
ピークゲート逆電圧 Peak Gate Reverse Voltage	V _{RGM}		5	V

■電気的特性 Electrical Characteristics

項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ピークオフ電流 Peak Off State Current	I _{DM}	T _j = 125°C, V _{DM} = V _{DRM}			30	mA
ピークオン電圧 Peak Off State Voltage	V _{TM}	T _j = 25°C, I _{TM} = 200A			1.20	V
トリガゲート電流 Gate Current to Trigger	I _{GT}	V _D = 6 V, I _T = 1A	T _j = -40°C		300	mA
			T _j = 25°C		150	
			T _j = 125°C		80	
トリガゲート電圧 Gate Voltage to Trigger	V _{GT}	V _D = 6 V, I _T = 1A	T _j = -40°C		5.0	V
			T _j = 25°C		3.0	
			T _j = 125°C		2.0	
非トリガゲート電圧 Gate Non-Trigger Voltage	V _{GD}	T _j = 125°C, V _D = 2/3 V _{DRM}	0.25			V
臨界オフ電圧上昇率 Critical Rate of Rise of Off State Voltage	dv/dt	T _j = 125°C, V _D = 2/3 V _{DRM}	500			V/μs
ターンオフ時間 Turn-Off Time	t _q	T _j = 125°C, I _{TM} = I _o , V _D = 2/3 V _{DRM} dv/dt = 20V/μs, V _R = 100V, -di/dt = 20A/μs		150		μs

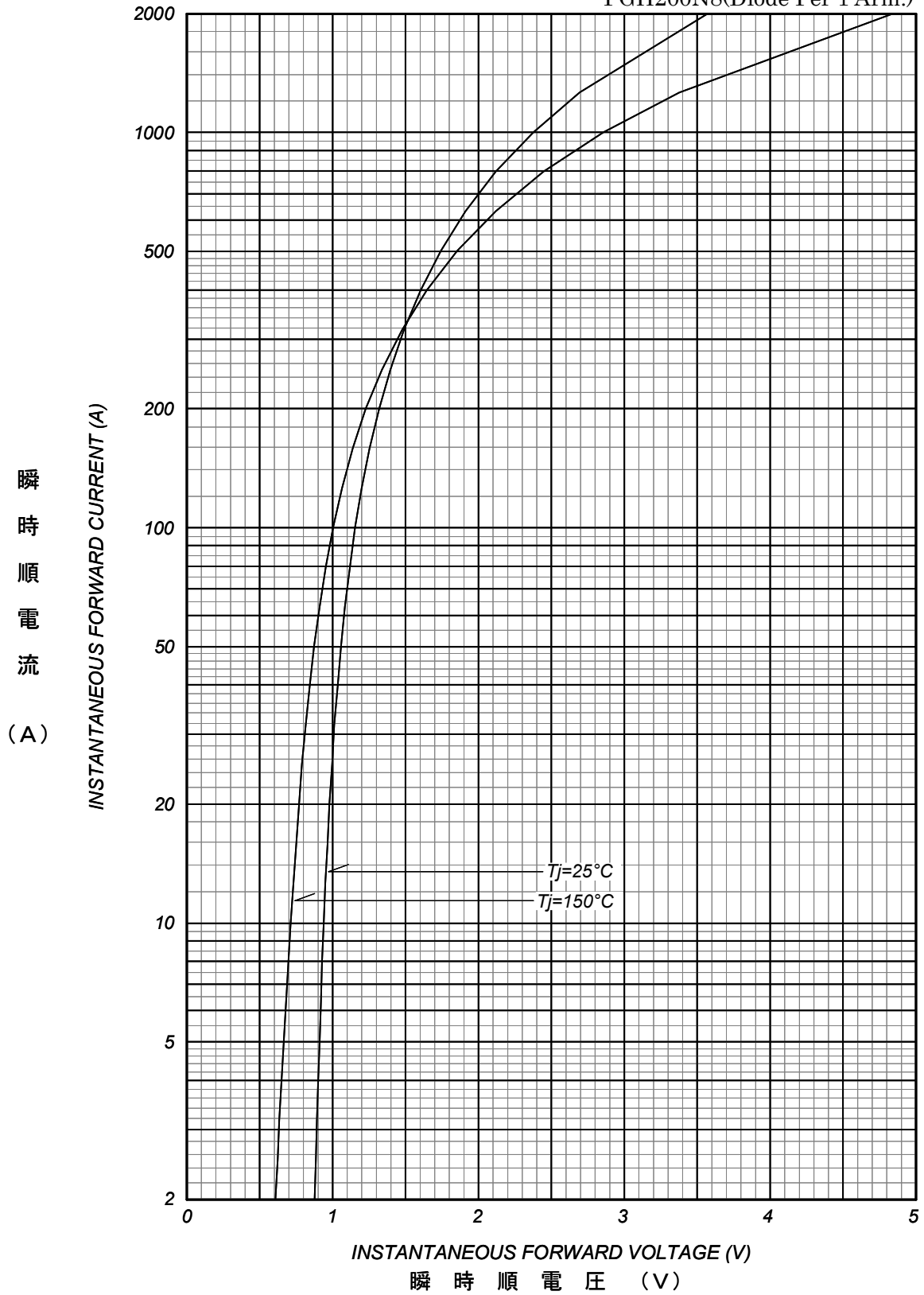
項目 Parameter	記号 Symbol	条件 Conditions	特性値 (最大) Maximum Value			単位 Unit
			最小 Min	標準 Typ	最大 Max	
ターンオン時間 Turn-On Time	t_{gt}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$, $V_D=2/3 V_{DRM}$, $I_T=3 \cdot I_O$ $I_G=300\text{mA}$, $di_G/dt=0.2\text{A}/\mu\text{s}$		6		μs
遅れ時間 Delay Time	t_d			2		μs
立ち上がり時間 Rise Time	t_r			4		μs
ラッチング電流 Latching Current	I_L	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		150		mA
保持電流 Holding Current	I_H	$T_j=25^{\circ}\text{C}$		100		mA
熱抵抗 Thermal Resistance	$R_{th(j-c)}$	接合部-ケース間 Junction to Case			0.22	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

質量 … 約 450g

Approximate Weight

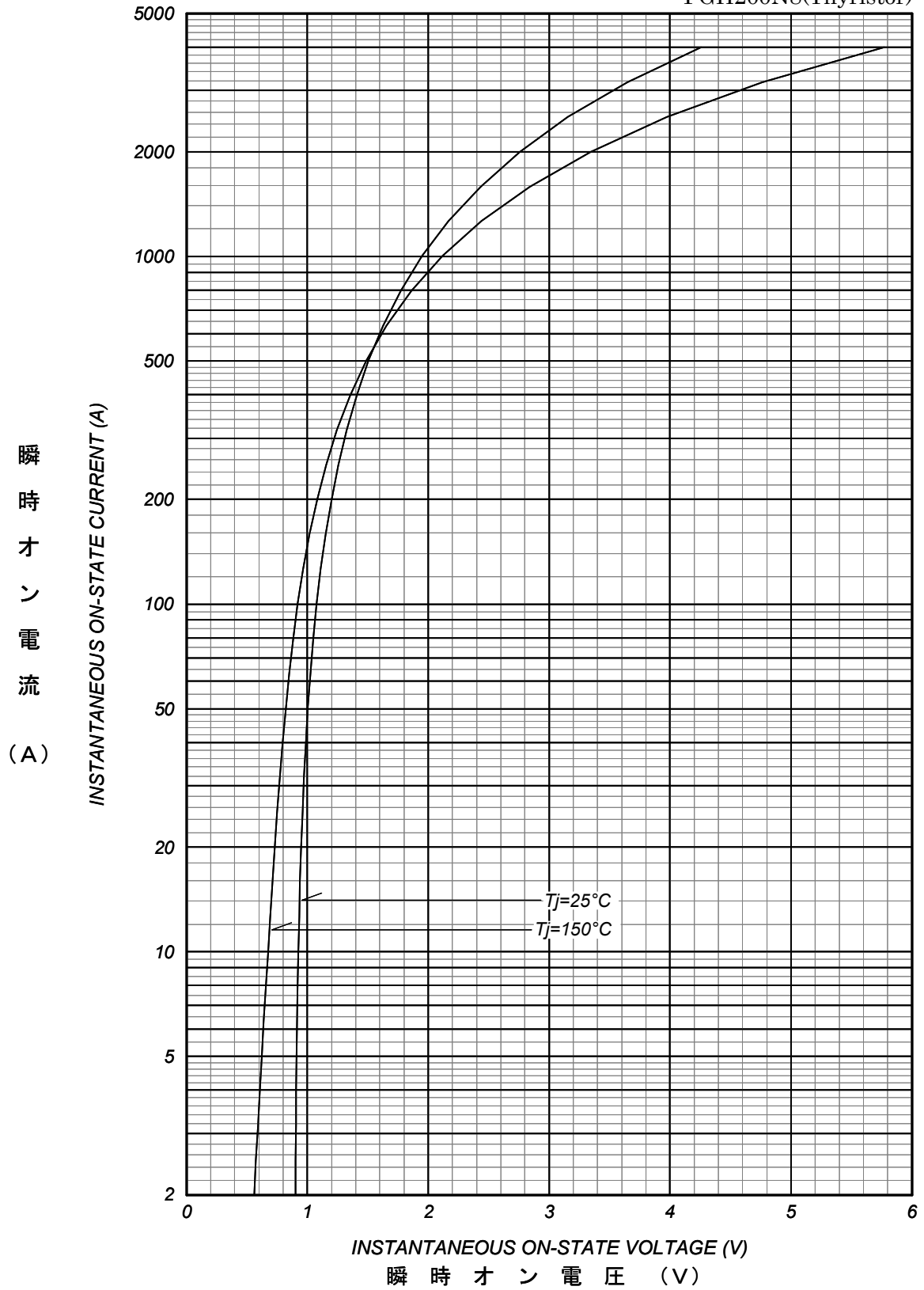
順電圧特性
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE

PGH200N8(Diode Per 1 Arm.)

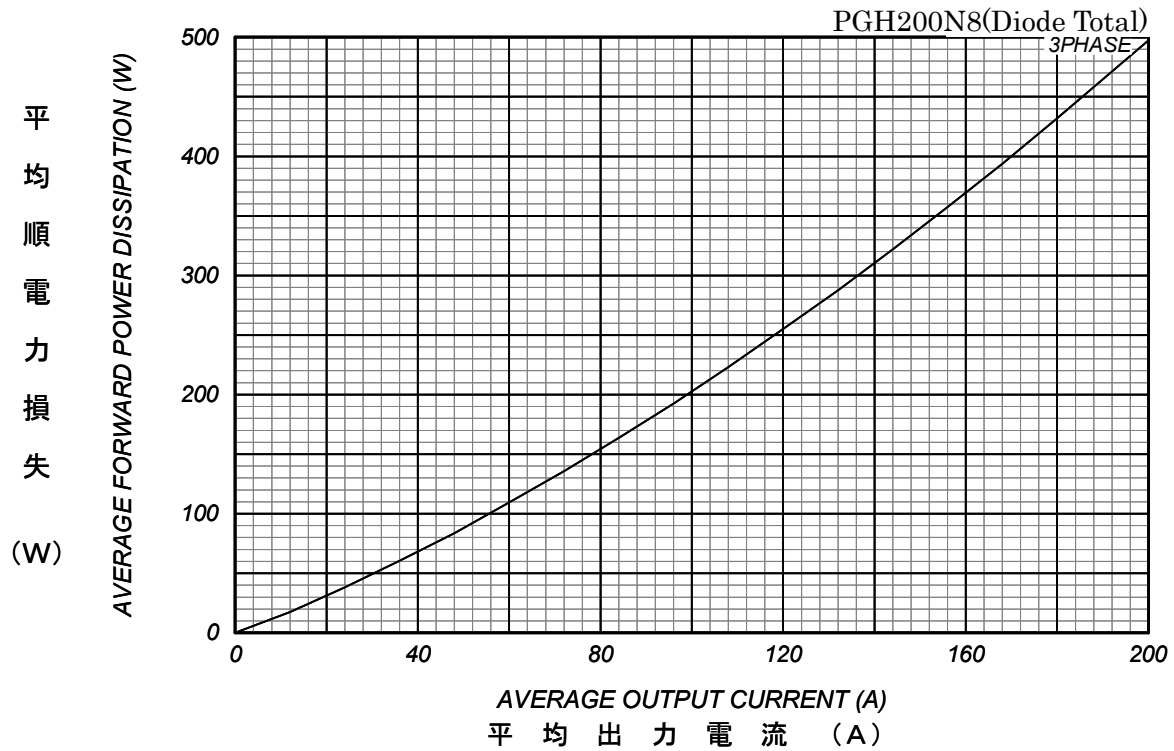


オン電圧特性
ON-STATE CURRENT VS. VOLTAGE

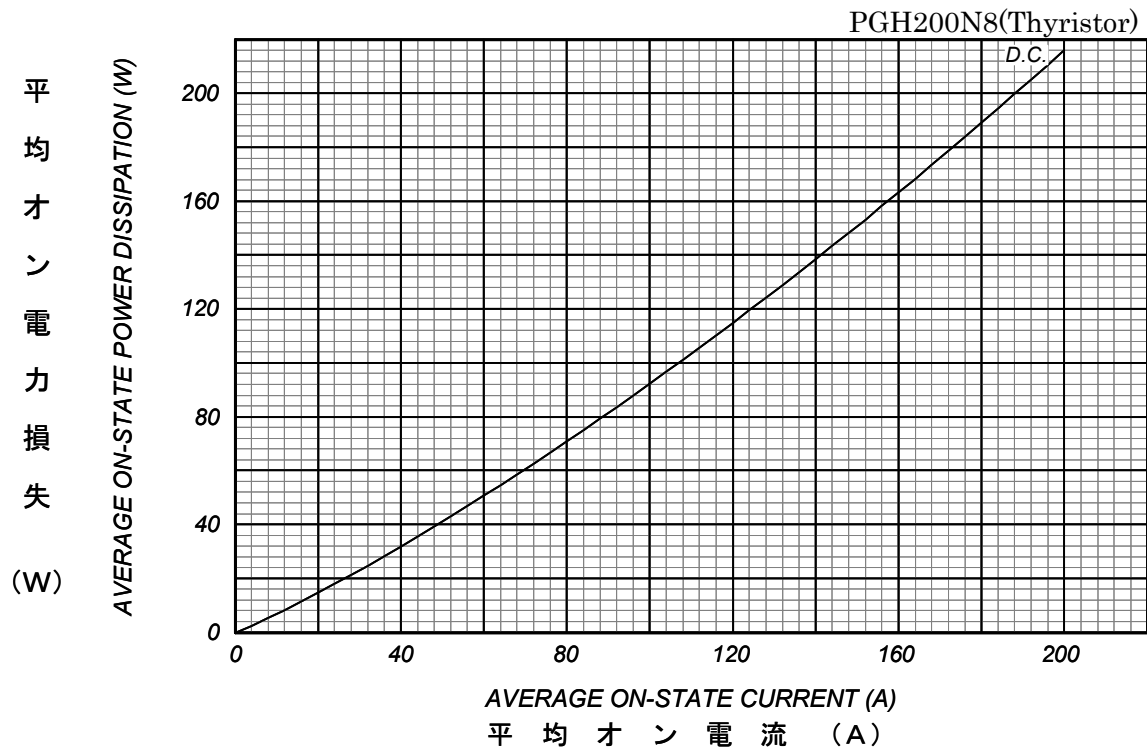
PGH200N8(Thyristor)



平均順電力損失特性
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION

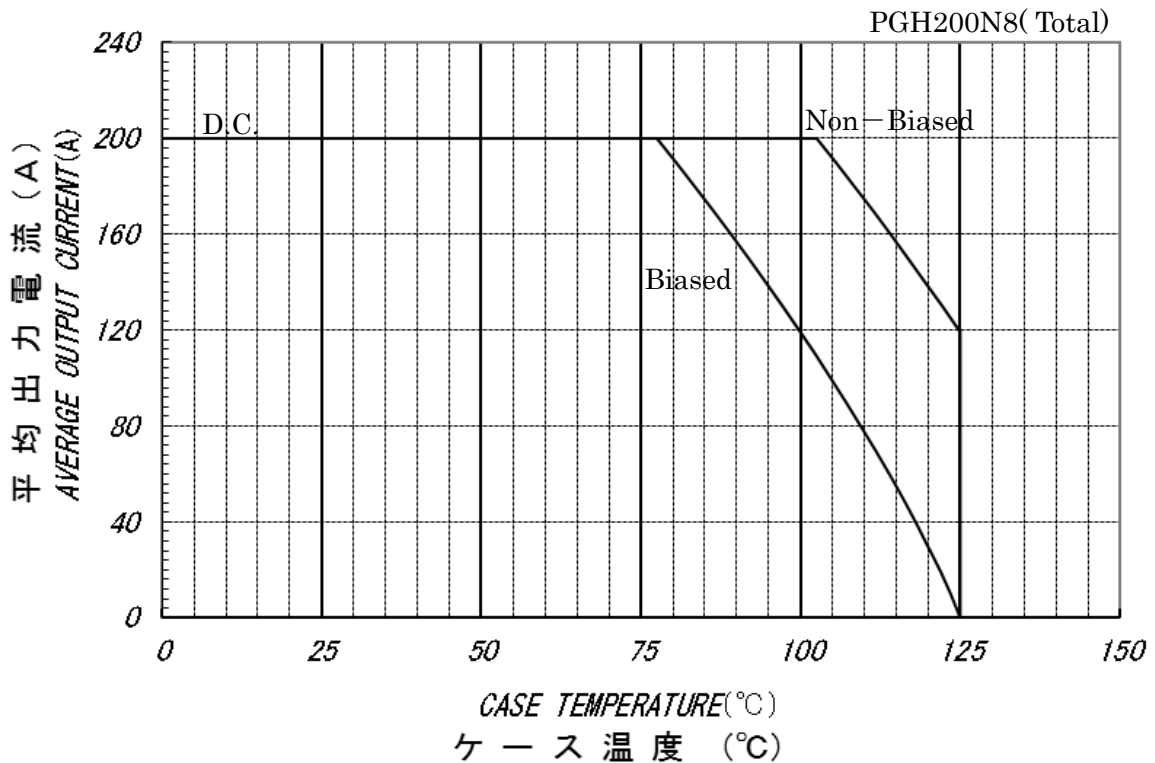


平均オン電力損失特性
AVERAGE ON-STATE POWER DISSIPATION



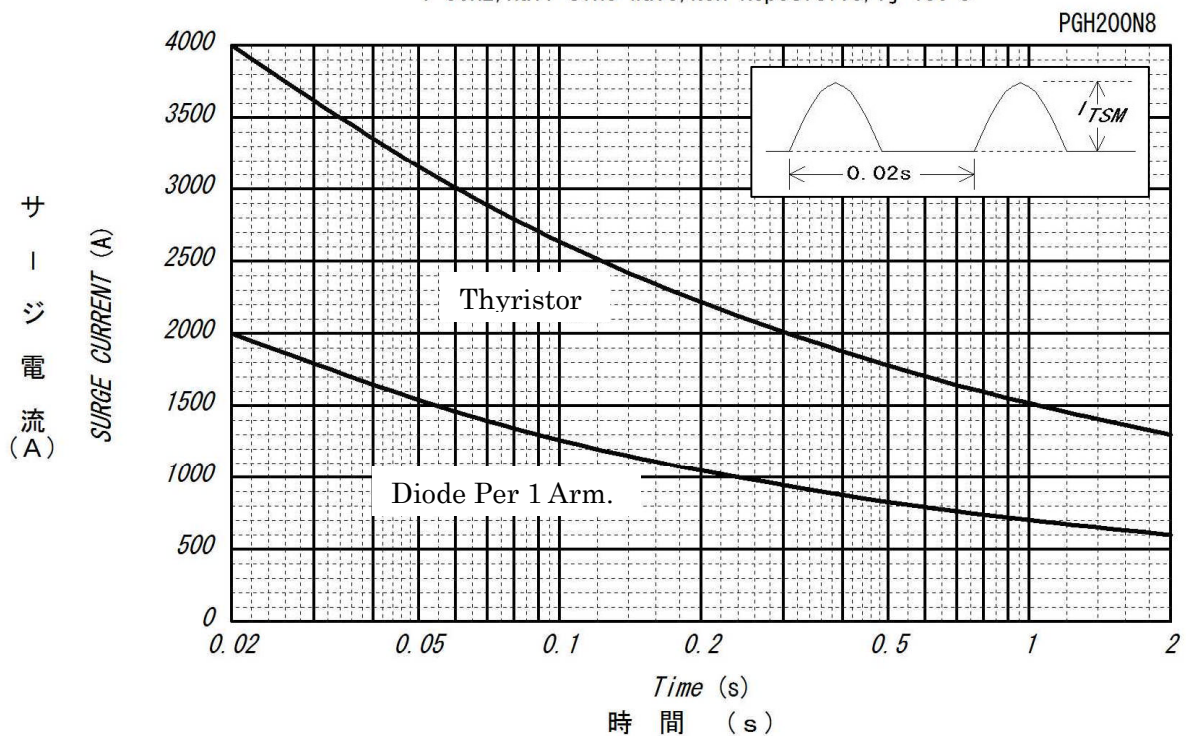
平均出力電流 - ケース温度定格
 AVERAGE OUTPUT CURRENT VS. CASE TEMPERATURE

3-Phase Full Wave, Resistive or Inductive Load

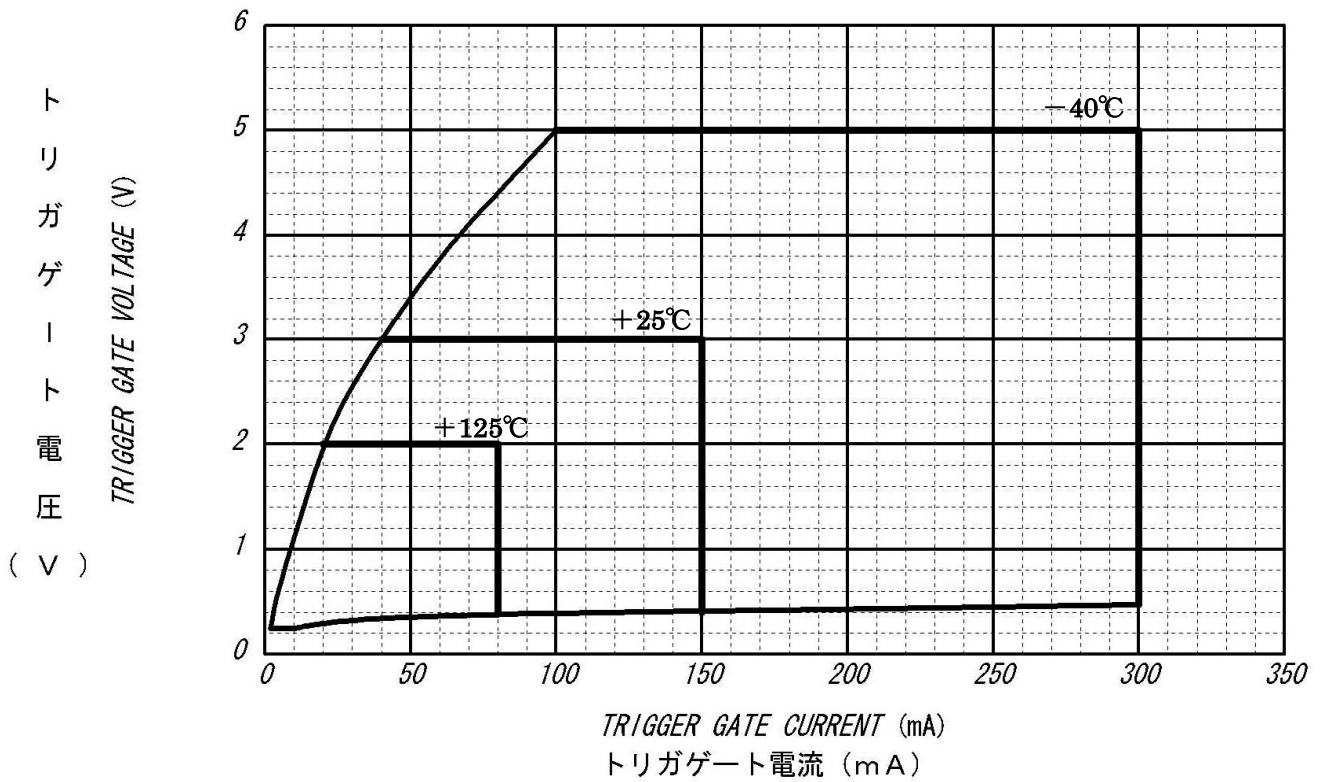


サージ電流定格
 SURGE CURRENT RATINGS

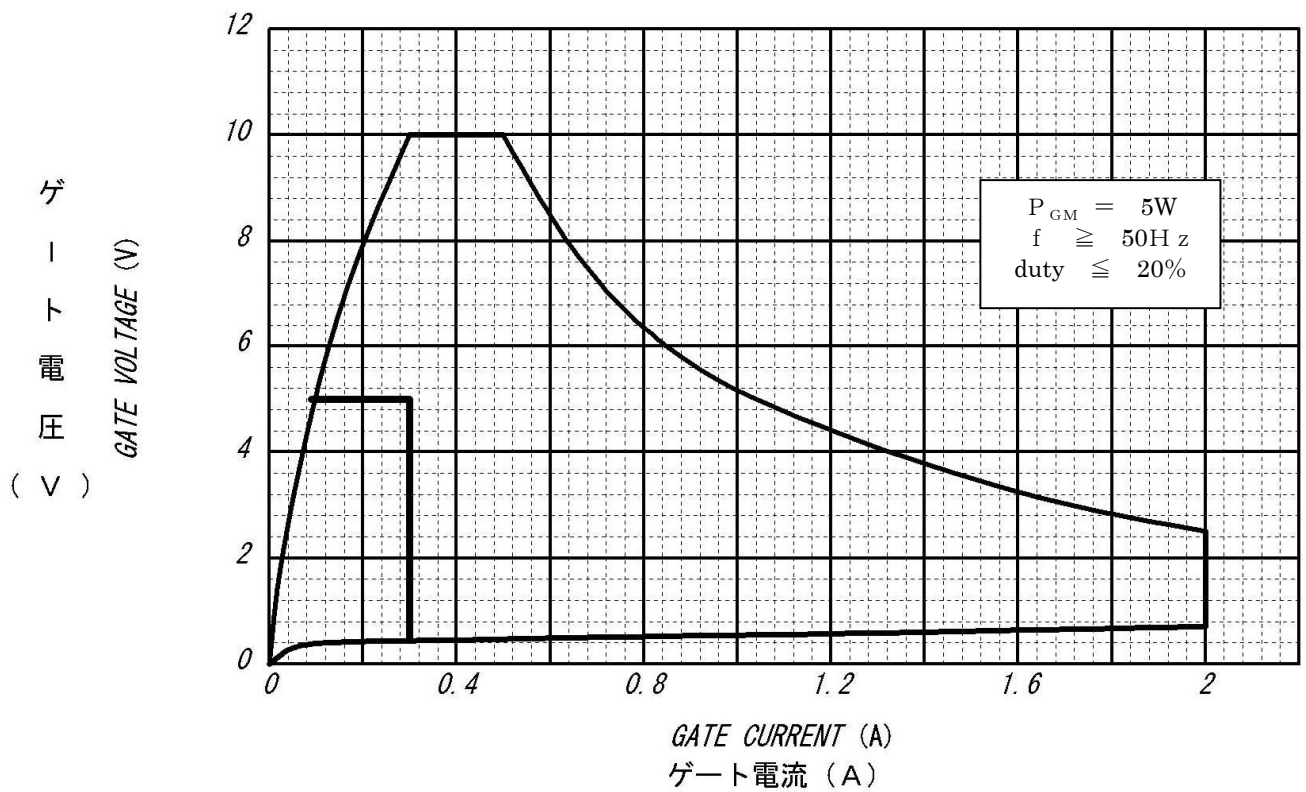
f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150°C



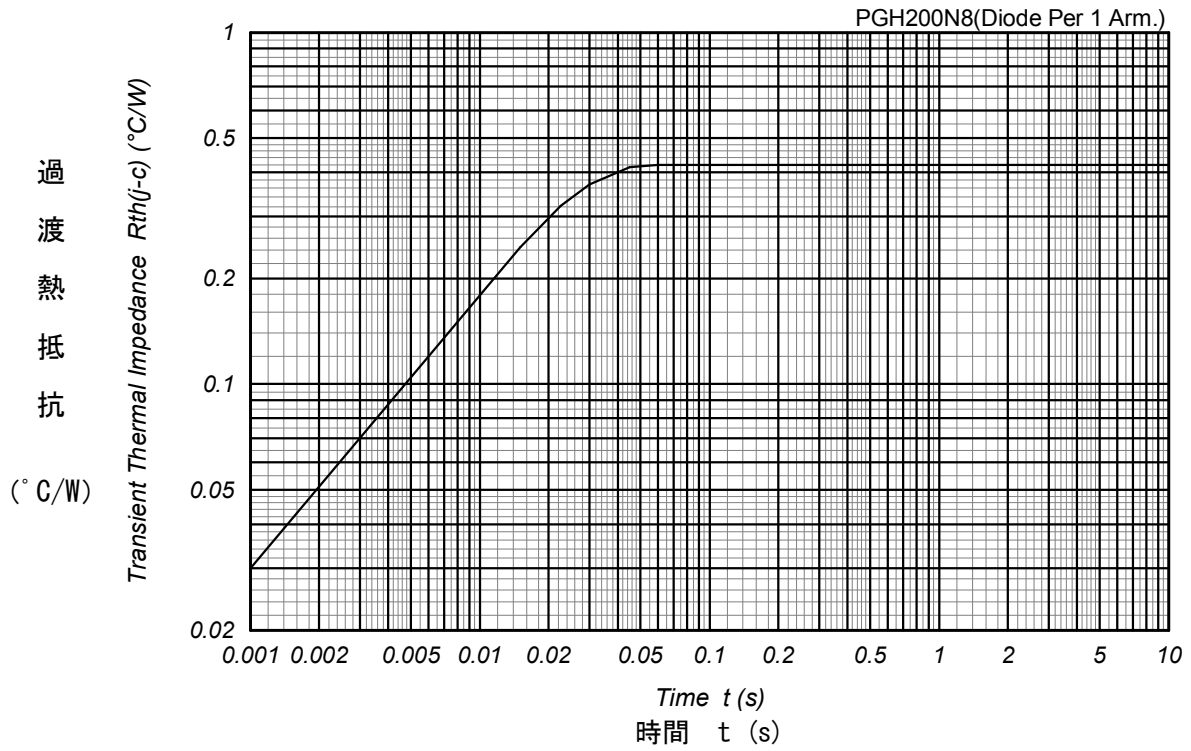
ゲート特性
GATE CHARACTERISTICS



ゲート定格
GATE RATINGS



過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Impedance



過渡熱抵抗特性
Transient Thermal Impedance

